

DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat

(c) 2002 EPO. All rts. reserv.

4693416

Basic Patent (No,Kind,Date): JP 59115564 A2 840704 <No. of Patents: 002>

THIN FILM TRANSISTOR (English)

Patent Assignee: SEIKO DENSHI KOGYO KK

Author (Inventor): SUZUKI TERUYA

IPC: \*H01L-029/78; H01L-021/318; H01L-027/12; H01L-029/62

CA Abstract No: \*102(06)054727K;

Derwent WPI Acc No: \*C 84-203562;

JAPIO Reference No: \*080235E000046;

Language of Document: Japanese

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applic No	Kind	Date	
<b>JP 59115564</b>	A2	840704	JP 82228188	A	821223	(BASIC)
JP 93046105	B4	930713	JP 82228188	A	821223	

Priority Data (No,Kind,Date):

JP 82228188 A 821223

DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2002 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

01403964      \*\*Image available\*\*

THIN FILM TRANSISTOR

PUB. NO.:      59-115564 [JP 59115564 A]

PUBLISHED:      July 04, 1984 (19840704)

INVENTOR(s):      SUZUKI TERUYA

APPLICANT(s):      SEIKO INSTR & ELECTRONICS LTD [000232] (A Japanese Company or Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.:      57-228188 [JP 82228188]

FILED:      December 23, 1982 (19821223)

INTL CLASS:      [3] H01L-029/78; H01L-021/318; H01L-027/12; H01L-029/62

JAPIO CLASS:      42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components)

JAPIO KEYWORD:      R004 (PLASMA); R097 (ELECTRONIC MATERIALS -- Metal Oxide Semiconductors, MOS)

JOURNAL:      Section: E, Section No. 275, Vol. 08, No. 235, Pg. 46,  
October 27, 1984 (19841027)

#### ABSTRACT

**PURPOSE:** To obtain a gate oxidized film which has good quality of film by forming a nitrided or oxidized film by a plasma CVD and then heat treating it at the special temperature or higher.

**CONSTITUTION:** A gate oxidized film 2 is formed on a gate electrode 3 on a glass plate 1, an amorphous Si or polysilicon layer 6 is selectively accumulated, source and drain electrodes 4, 5 are attached, and a protective film 7 is covered, thereby completing a thin film transistor. In case of forming the film, the flow ratio of the  $\text{Si}(\text{sub } 4)/\text{N}(\text{sub } 2)\text{O}$  is selected to 1/7-1/150, an  $\text{SiO}(\text{sub } 2)$  film is formed at 0.01- 1Torr, 10-50W of electric power, and 100-300c of substrate temperature, and calcined in  $\text{N}(\text{sub } 2)$  at 400c or higher. The film formed by this plasma CVD method has a boundary level reduced by approximately 1/10 order, its withstand voltage is improved by approximately 10 times, and pinholes are further reduced. Even if an  $\text{Si}(\text{sub } 3)\text{N}(\text{sub } 4)$  film is formed with  $\text{SiH}(\text{sub } 4)+\text{NHO}(\text{sub } 3)+\text{N}(\text{sub } 2)$  gas, similar effect can be obtained, hysteresis can be remarkably reduced, and it is extremely effective to improve the characteristics of either film.

⑬ 日本国特許庁 (JP)

⑭ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭59—115564

⑪ Int. Cl.<sup>3</sup>  
H 01 L 29/78  
// H 01 L 21/318  
27/12  
29/62

識別記号

庁内整理番号  
7377—5F  
7739—5F  
8122—5F  
7638—5F

⑬ 公開 昭和59年(1984)7月4日

発明の数 1  
審査請求 未請求

(全 3 頁)

⑭ 薄膜トランジスタ

⑯ 特 願 昭57—228188  
⑰ 出 願 昭57(1982)12月23日  
⑱ 発 明 者 鈴木光弥  
東京都江東区亀戸 6 丁目31番 1

号株式会社第二精工舎内  
⑲ 出 願 人 セイコー電子工業株式会社  
東京都江東区亀戸 6 丁目31番 1  
号  
⑳ 代 理 人 弁理士 最上務

明 細 書

1. 発明の名称 薄膜トランジスタ

2. 特許請求の範囲

基板，ゲート，ゲート絶縁膜，半導体膜，ソース，ドレインなどからなる薄膜トランジスタにおいて、ゲート絶縁膜はプラズマ CVD によつて作成した窒化膜または酸化膜であり、かつ、その膜は温度 400℃ 以上で熱処理した膜であることを特徴とする薄膜トランジスタ。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、薄膜トランジスタに関し、特に、ゲート絶縁膜は、プラズマ CVD (あるいはグロー放電 CVD ともいわれる) で作成し、次に熱処理したゲート絶縁膜に関するものである。

近年、アクティブマトリクスを使つた液晶ディスプレイ、特に液晶テレビ等の研究開発が行なわれている。アクティブマトリクスとして、シリコ

ン単結晶を基板にした MOS トランジスタを使う他に、薄膜トランジスタによる液晶ディスプレイがある。薄膜トランジスタの場合は、シリコン単結晶ウェハーを基板にした MOS アレイと比較して、基板として透明なガラス基板を使用でき、そのために、ツイストネマティック液晶モードを使うことができ、コストが安くなり、さらに、大型ディスプレイを作ることができる。その反面、ガラス基板を使う場合は、シリコン単結晶の場合と異なり、トランジスタ製造プロセスは、温度 500℃ 以下の低温プロセスとする必要がある。低温でゲート絶縁膜を作成する方法として、通常、低圧力による CVD 法があるが、温度 500℃ で作成した酸化膜は、界面準位が  $1 \times 10^{11}$  以上あり、耐圧が低く、ピンホールがあり、良い膜質のゲート絶縁膜が得がたい。

本発明は、上述の欠点を除去するために、温度 100～300℃ で、プラズマ CVD によつて、窒化膜、あるいは酸化膜を作成し、次に温度 400℃ 以上で熱処理を行なうことにより、所望のゲー

ト絶縁膜を得ることを目的とする。

次に本発明を詳細に説明する。

第1図は、本発明の薄膜トランジスタの縦断面図を示し、1は透明基板であり、石英ガラスや通常のガラスを使用する。2はゲート絶縁膜であり、プラズマCVD法によつて作成し、窒化膜SiNHや酸化膜SiON膜であり、3はゲート電極、4はドレイン電極、5はソース電極であり、各電極は、Al, Al-Si, ポリシリコン, 金, クロムなどからなる電極である。6は半導体膜であり、アモルファスシリコンや、ポリシリコン膜を使用する。7はパッシベーション膜であり、PSG、または窒化膜である。

次に、本発明によるゲート絶縁膜の製造方法と、その膜質についての実験結果を述べる。

まず、プラズマCVDを使つたSiON膜は、次の方法によつて作成した。使用ガスは、SiH<sub>4</sub>, N<sub>2</sub>O であり、SiH<sub>4</sub>/N<sub>2</sub>O 流量比 1/1 ~ 1/150 とし、デポジション圧力 0.1 ~ 1 torr, 放電Power 10 ~ 50 watts, 基板温度 100 ~ 300 °C で

ルが低下した。プラズマCVDによる窒化膜について、次に述べる。使用ガスは、SiH<sub>4</sub>, HNO<sub>3</sub>, N<sub>2</sub> ガスを使用した。SiH<sub>4</sub>/NH<sub>3</sub> 流量比 1/2 ~ 2, N<sub>2</sub> 10 ~ 100 SCCM, 圧力 0.1 ~ 0.5 torr, 放電Power 10 ~ 100 watts, 基板温度 200 ~ 300 °C とした。次に、温度 400 °C 以上で水素雰囲気中で焼成した。その結果、酸化膜の場合と同様の傾向を得ることができ、エッチレートで約 1/2, 界面単位で 1 ケタ低下した。

第2図は、本発明で用いるプラズマCVDで作成した窒化膜のMIS構造の容量対電圧特性を示し、水素雰囲気中で焼成した場合の特性10は、水素焼成しない場合の特性11と比較し、ヒステリシスの幅が約 1/2 となつた。

以上述べてきたように、本発明によるプラズマCVDによつて作成し、次に熱処理した絶縁膜は、界面単位の向上、エッチレートの低下、耐圧の向

ある。このようにして作成した酸化膜を、さらに温度 450 °C、窒化雰囲気中で焼成した。これらの絶縁膜と、他の方法で作成した絶縁膜を比較したデータを下の表に示す。

表

製造法	界面単位 Qss/q	ピンホール (膜厚約1000Å)	耐圧 V/cm	エッチレート BHF (Å/sec)
Low Pressure CVD	1×10 <sup>12</sup>	大	1×10 <sup>6</sup>	100
Plasma CVD	8×10 <sup>11</sup>	小	3×10 <sup>6</sup>	100
Plasma CVD +450°C熱処理	2×10 <sup>11</sup>	ほとんどない	1×10 <sup>7</sup>	50

表から明らかなように、プラズマCVDによつて作成した酸化膜は、高温低圧CVDで作成した酸化膜より、膜質は少し良くなり、さらに、温度 450 °C で焼成した膜は、焼成しない場合と比較して、エッチレートが約 1/2, 界面単位が約 1 ケタ低下し、耐圧が約 10 倍増加し、さらにピンホー

上、また窒化膜に関しては、ヒステリシスの減少が顕著にみられ、薄膜トランジスタの特性向上に極めて有効である。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の薄膜トランジスタの縦断面図、第2図は、本発明で用いるプラズマCVDで作成した窒化膜の電気特性図である。

- 1…透明基板
- 2…ゲート絶縁膜
- 3…ゲート
- 4…ドレイン
- 5…ソース
- 6…半導体膜
- 7…保護膜

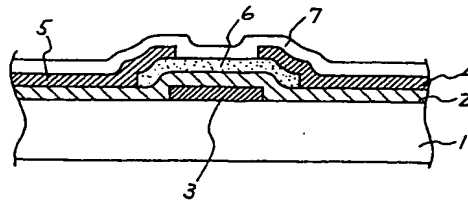
- 11…プラズマCVDによる窒化膜の特性
- 12…11を水素雰囲気中で熱処理した特性

以上

出願人 株式会社 第二精工舎  
代理人 弁理士 殿上



第 1 図



第 2 図

